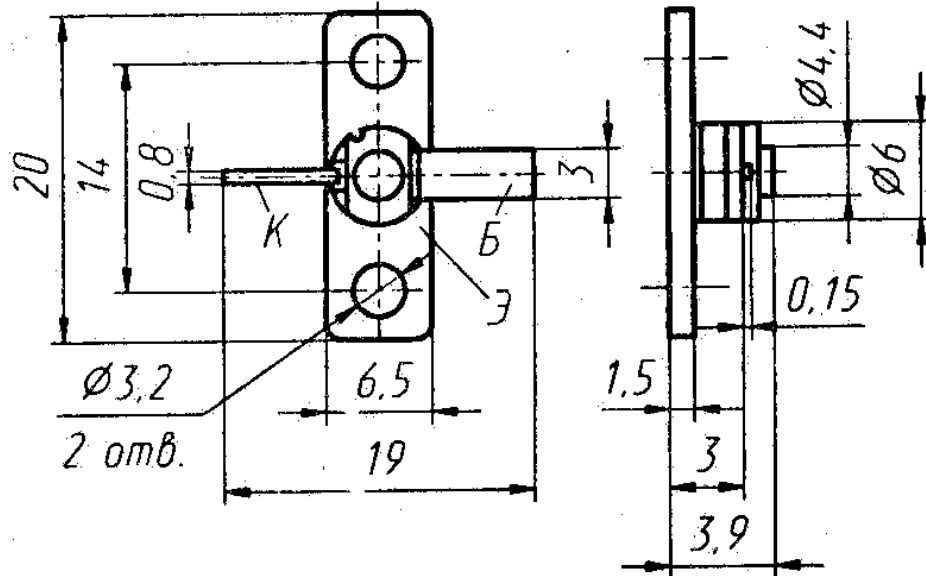


A792

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры n-p-n усилительный линейный. Предназначен для применения в линейных усилителях мощности в схеме с общим эмиттером на частотах до 2,3 ГГц. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами. Транзистор маркируется буквой «Г» и точкой красного цвета. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 3 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва



Электрические параметры

Выходная мощность на $f = 2,3$ ГГц при $U_{кб} = 18$ В, $I_k = 380$ мА	
не менее	2,1 Вт
среднее значение	2,5 Вт
Коэффициент усиления по мощности на $f = 2,3$ ГГц	
при $U_{кб} = 18$ В, $I_k = 380$ мА	не менее 5,5 дБ
Коэффициент полезного действия коллектора на $f = 2,3$ ГГц	
при $U_{кб} = 18$ В, $I_k = 380$ мА	не менее 30,7%
Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{кэ} = 22$ В, $R_{бэ} = 100$ Ом	не более 10 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 3,5$ В	не более 2 мА

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер* при $R_{бэ} = 100$ Ом	22 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	3,5 В
Потенциал статического электричества	1000 В
Постоянный ток коллектора	550 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора** при $T_k = -60...+50$ °С	9 Вт
Температура p-n перехода	+160 °С
Тепловое сопротивление переход—корпус	12,2 °С/Вт
Температура окружающей среды	-60... $T_k = +125$ °С

- $U_{кэ} > 20$ В допускается только при закрытом эмиттерном переходе.
- При $T_k > +50$ °С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{к, \max} = (160 - T_k) / 12,2, \text{ Вт.}$$

Транзистор допускает применение статического режима и усиления в классе «А». Не рекомендуется работать при напряжении питания выше 16 В на рабочих частотах ниже 600 МГц.

Расстояние от корпуса до места лужения и пайки не менее 1,5 мм, температура припоя +260°С, время пайки не более 3 с. Расстояние от корпуса до начала изгиба вывода не менее 3 мм. Разрешается обрезать полосковые выводы на расстоянии не менее 1,5 мм от корпуса, а также формовать выводы на расстоянии не менее 1 мм от корпуса.